



INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU
OPTOELECTRONICA



CERT NO.: AJAEU/09/11337

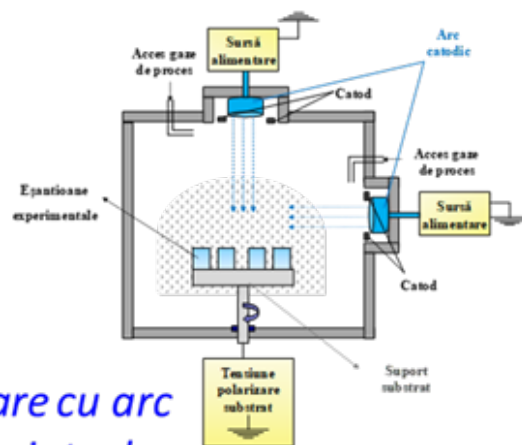
Certificat nr.: AJAEU/09/11337

Str. Atomistilor Nr.409, C.P. MG-5, Cod 077125, Magurele - Ilfov, Telefon/Fax: 021.457.45.22, E-mail:inoe@inoe.inoe.ro, http://inoe.inoe.ro

FIȘĂ TEHNICĂ

"Documentatie privind obtinerea si caracterizarea unor structuri cu arhitectura multistrat pe baza de oxinitruri metalice nedopate si dopate cu Si"

Domeniul de utilizare: <i>Materiale biocompatibile</i>	
Tip: <i>Documentație tehnico-economică</i>	Brevete:
Status: <i>Nou</i>	Data: 2023/06/14
Proiectant: <i>INOE 2000 - Sisteme tehnologice bazate pe plasma si vid pentru noi materiale avansate nanostructurate</i>	Executant: <i>INOE 2000 - Sisteme tehnologice bazate pe plasma si vid pentru noi materiale avansate nanostructurate</i>



Instalatia de evaporare cu arc catodic si schema incinta de depunere instalatie

Date tehnice: Documentatie tehnica despre metoda de depunere cu rata mare de depunere, utilizata industrial, a straturilor prin evaporare in atmosfera reactiva a materialului catodului prin producerea unei descarcari in arc. Pentru obtinerea straturilor subtiri de nitrura si oxinitrura de Ti s-au utilizat catozi de tip Ti si TiSi (93% at. Ti - 7% at. Si, 99.9% puritate). Straturile au fost depuse pe substraturi de Si (0,3 μm grosime, 2,54 cm diametru) si oțel inoxidabil 316L (2 mm grosime, 20 mm diametru). Descriere a metodelor de caracterizare a straturilor